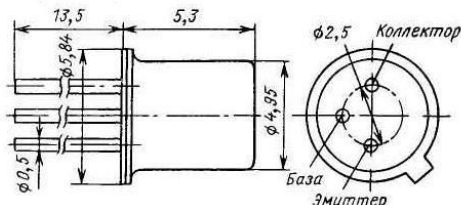


КТ342А, КТ342Б, КТ342В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* типа инверсионные высокочастотные маломощные.
 Предназначены для усиления и генерирования сигналов в широком диапазоне частот.
 Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.
 Обозначение типа приводится на корпусе.
 Масса транзистора не более 0,5 г.



Пределы эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, $I_{КЭ} = 30 \text{ мкА}$ при $T = 213 - 373 \text{ К}$

КТ342А	30 В
КТ342Б	25 В
КТ342В	10 В

при $T = 398 \text{ К}$

КТ342А	25 В
КТ342Б	20 В
КТ342В	10 В

Граничное напряжение при $I_3 = 5 \text{ мА}$:

при $T = 213 - 373 \text{ К}$	
КТ342А	25 В
КТ342Б	20 В
КТ342В	10 В
при $T = 398 \text{ К}$	
КТ342А	20 В
КТ342Б	15 В
КТ342В	10 В

Постоянный ток коллектора 50 мА

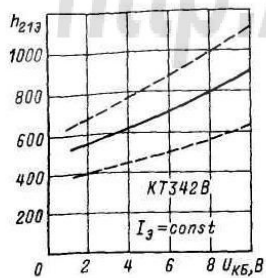
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 40 \text{ мкс}$, $Q > 500$ 300 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

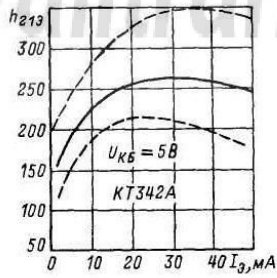
при $T = 213 - 298 \text{ К}$	250 мВт
при $T = 398 \text{ К}$	50 мВт

Температура перехода 423 К

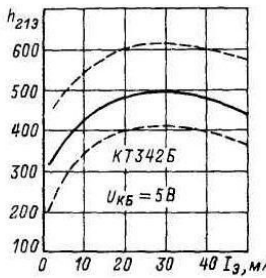
Температура окружающей среды От 213 до 398 К



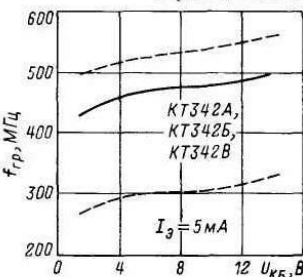
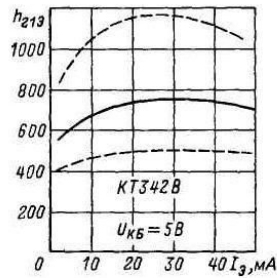
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база.



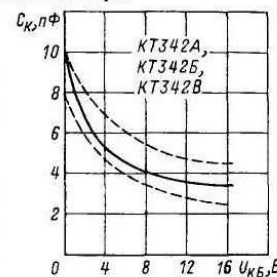
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зоны возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зона возможных положений зависимости граничной частоты от напряжения коллектор база



Зона возможных положений зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база

Электрические параметры

статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{К} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 1 \text{ мА}$

при $T = 213 \text{ К}$	
КТ342А	25—250
КТ342Б	50—500
КТ342В	100—1000
при $T = 298 \text{ К}$	
КТ342А	100—250
КТ342Б	200—500
КТ342В	От 400—1000
при $T = 398 \text{ К}$	
КТ342А не менее	100
КТ342Б не менее	200
КТ342В не менее	400

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{К} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ МГц}$ не менее

КТ342А	2,5
КТ342Б, КТ342В	3

Обратный ток коллектора не более

при $T = 213 \text{ К}$	
при $U_{КБ} = 25 \text{ В}$ КТ342А	1 мкА
при $U_{КБ} = 20 \text{ В}$ КТ342Б	1 мкА
при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ КТ342В	1 мкА
при $T = 298 \text{ К}$	
при $U_{КБ} = 25 \text{ В}$ КТ342А	0,05 мкА
при $U_{КБ} = 20 \text{ В}$ КТ342Б	0,05 мкА
при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ КТ342В	0,05 мкА
при $T = 398 \text{ К}$	
при $U_{КБ} = 25 \text{ В}$ КТ342А	10 мкА
при $U_{КБ} = 20 \text{ В}$ КТ342Б	10 мкА
при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ КТ342В	10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5 \text{ В}$ не более 30 мкА

Обратный ток коллектор эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$ не более

при $U_{КЭ} = 30 \text{ В}$ КТ342А	30 мкА
при $U_{КЭ} = 25 \text{ В}$ КТ342Б	30 мкА
при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$ КТ342В	30 мкА

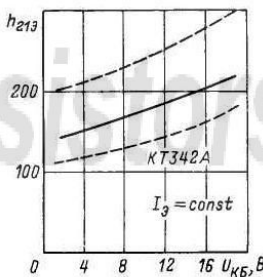
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, $I_3 = 1 \text{ мА}$ не более 0,1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, $I_3 = 1 \text{ мА}$ не более 0,9 В

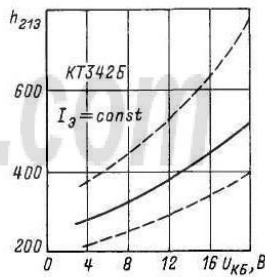
Граничное напряжение при $I_3 = 5 \text{ мА}$ не менее

КТ342А	25 В
КТ342Б	20 В
КТ342В	10 В

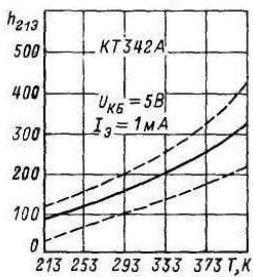
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ не более 8 пФ



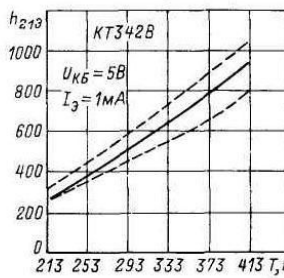
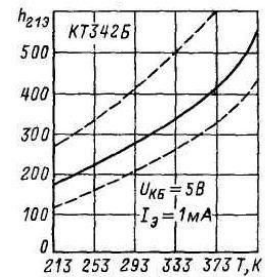
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база.



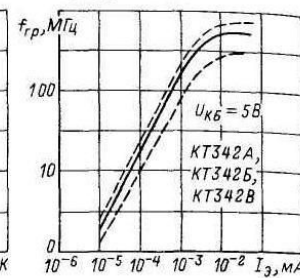
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база.



Зоны возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



Зона возможных положений зависимости граничной частоты от тока эмиттера